Amplificador de Potencia

Sueldo Enrique 62508

Sosa Javier 65337

Ponce Nicolás 64725

Schamun Lucas

Universidad Tecnológica Nacional- Facultad Regional Córdoba

I. INTRODUCCIÓN

Los amplificadores de potencia de RF se emplean cuando es importante la eficiencia y la potencia de un circuito amplificador. Los diversos tipos de amplificadores se identifican por su clase de operación, es decir A, B, C, D, E, F, G, H y S. Exceptuando el A, los demás se diferencian fácilmente de los de señal débil por sus configuraciones de circuitos, sus métodos de operación o por ambos.

Los amplificadores de potencia de RF clase A y B tienen una ganancia apreciable; producen una réplica amplificada del voltaje de la señal de entrada o de la onda de corriente y se usan comúnmente (sin clase C) en transmisores SSB y multimodo, donde se requiere la reproducción exacta de la envolvente y de la fase de la señal. Los circuitos sintonizados no son parte integral de los amplificadores en clase A y B, pero se los incluye para asegurar la supresión adecuada de armónicas.

Muchas aplicaciones no requieren amplificación lineal en RF y pueden por consiguiente utilizar una mayor eficiencia y sencillez ofrecidas por los amplificadores de potencia sintonizados en clase C. Tales aplicaciones incluyen amplificación de señales CW, FM y AM (en banda lateral doble y completa). Las señales CW y FM tienen como máximo dos posibles valores de amplitud; la variación de amplitud que se requiere para una señal de AM se realiza por variación del voltaje de alimentación del amplificador.

II. OBJETIVO

Diseñar, calcular e implementar un amplificador de gran eficiencia alimentado con una Vcc de 12v, una resistencia de carga de 50Ω , una potencia de entrada del orden de 1 a 5mW y una potencia de salida de 1W.

Para la entrada se utiliza la salida del modulador de FM del práctico anterior.

Se plantea un amplificador de potencia de 2 etapas desarrollado con 3 transistores: MRF4427, BFR96TS y BFR90A. En la primera etapa se emplea una configuración clase A con choque en colector y la segunda etapa, de potencia, se utiliza una configuración clase C.

El circuito cuenta también con 3 redes de adaptación de impedancias: la de generador-entrada del amplificador, la primera etapa con la segunda y finalmente la salida del amplificador con la carga.

III. DESARROLLO

Cálculos de ganancia

En una primera instancia se calcula la ganancia que tendrá el amplificador para llevar la potencia a 1W.

$$G = \frac{P_{OUT(W)}}{P_{IN(W)}} = \frac{1W}{1mW} = 1000$$

$$G_{dB} = 10\log(1000) = 30dB$$

Cálculos para el transistor 2N4427(etapa de salida):

2.1 Potencia:

En la hoja de datos del componente se obtuvo:

- $\begin{aligned} P_{Out\ M\acute{a}x} &= 3.5W \\ V_{CC} &= 12v \end{aligned}$
- $I_{C M\acute{a}x} = 400 mA(DC)$ $F_{M\acute{a}x} = 400 MHz$
- Gain > 10dB@175MHz

Se desea obtener 1.33W de salida, con una Potencia de entrada de 84mW, por lo que la ganancia de este transistor

$$G = \frac{P_{OUT(W)}}{P_{IN(W)}} = \frac{1.33W}{84mW} = 16$$

$$G_{dB}=10\log(16)=12dB$$

2.2 Impedancia:

A partir de la hoja de datos, se obtienen los parámetros S:

• $S_{11} = 0.712 L^{-163} = -0.68 - j0.2081$ • $S_{12} = 0.026 L^{44}$ • $S_{22} = 0.271 L^{-67} = -0.106 - j0.249$ • $S_{21} = 10.78 L^{96}$

Con estos datos, es posible calcular la impedancia de entrada

$$Z_{IN} = \frac{1 + S_{11}}{1 - S_{11}} * R_L = \frac{1 + (-0,68 - j0,2081)}{1 - (-0,68 - j0,2081)} * 50$$
$$= 8,6 - j7,32$$

$$Z_{OUT} = \frac{1 + S_{22}}{1 - S_{22}} * R_L = \frac{1 + (-0,106 - j0,249)}{1 - (-0,106 - j0,249)} * 50$$

= 53,80 - j28,91

Se establece la potencia de salida:

$$P_{OUT} = \frac{\widehat{V_{ce}}}{\sqrt{2}} * \frac{\widehat{I_c}}{\sqrt{2}} = \left(\frac{\widehat{V_{ce}}}{\sqrt{2}}\right)^2 * \frac{1}{R_e(Zout)} = \left(\frac{12}{\sqrt{2}}\right)^2 * \frac{1}{53.8} = 1.33$$
W

Según los valores especificados, la potencia calculada se encuentra dentro del rango de trabajo del transistor, al igual que la corriente (menor a 400mA):

$$I_{RMS} = \sqrt{\frac{P_{OUT}}{R_e(Zout)}} = \sqrt{\frac{1,33}{53,8}} = 157,2 \text{ mA}$$

Con la potencia de entrada se puede calcular Vin:

$$P_{in} = \left(\frac{\widehat{V_{IN}}}{\sqrt{2}}\right)^{2} * \frac{1}{R_{e}(Zin)} \to \widehat{V_{IN}} = \sqrt{2 * P_{in} * R_{e}(Zin)}$$
$$= \sqrt{2 * 0.08891 * 8.6} = 1.2V$$

2.3 Polarización de etapa de salida:

$$V_{CEQ} = V_{CC} = 12v$$

$$Z_L = R_e(Zo) = 53.8$$

$$I_{CMAX} = \frac{V_{CEQ}}{Z_L} = \frac{12}{53.8} = 223.13 mA$$

Para calcular los choques se supone:

$$X_L = 10 * Z_L = 10 * 53.8 = 538 \Omega$$

$$L_R = \frac{X_L}{2 * \pi * F_{MAX}} = \frac{538 \Omega}{2 * \pi * 88MHz} = 972,65 \ nHz$$

Se utilizan choques de 4uH con ferrites BK200, con lo cual el circuito quedaría conformado de la siguiente manera:

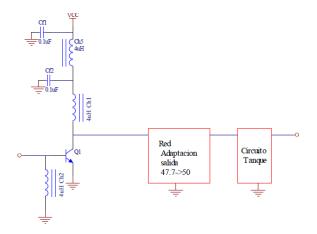


FIG. 1: ETAPA DE SALIDA

Diseño de la etapa de entrada.

En la hoja de datos del componente BFR90 se obtuvo:

- $\begin{aligned} P_{Out\ M\acute{a}x} &= 300 \text{mW} \\ V_{CC} &= 5v \end{aligned}$
- $I_{C M\acute{a}x} = 30 \text{mA}$
- $F_{M\acute{a}x} = 200MHz$
- Gain > 16dB@500MHz

Para entregar al BFR96 la potencia necesaria sumamos 1.12mW a la potencia de entrada calculada anteriormente, por

$$P_{out} = 0.35mW + 1.12 mW = 0.392 mW$$

Considerando

$$I_{CQ} = 10mA$$
 $V_{ce} = 5V$

3.1 Impedancia:

A partir de la hoja de datos, se obtienen los parámetros S:

- $S_{11} = 0.45 L^{-54.6} = -0.26 j0.37$ $S_{22} = 0.799 L^{-21.5} = 0.74 j029$ $S_{12} = 0.02 L^{70.4}$ $S_{21} = 18.55 L^{133.7}$

Con estos datos, es posible calcular la impedancia de entrada y de salida:

$$Z_{IN} = \frac{1 + S_{11}}{1 - S_{11}} * R_L = \frac{1 + (-0.26 - j0.37)}{1 - (-0.26 - j0.37)} * 50$$

= 58.57 - j53.7

$$Z_{OUT} = \frac{1 + S_{22}}{1 - S_{22}} * R_L = \frac{1 + (0.74 - j029)}{1 - (0.74 - j029)} * 50$$
$$= 122,61 - j184,75$$

Se calcula la tensión de salida:

$$\widehat{V}_o = \sqrt{2 * P_{out} * R_e(Zo)} = \sqrt{2 * 0.392 * 122.61}$$

= 310mV

Con la cual se puede calcular la corriente para MES:

$$I_{CQ} = \frac{\hat{V_o}}{R_e(Zo)} = \frac{310mV}{122,61} = 2,52 \text{ mA}$$

Con ambos valores, se puede obtener la potencia Pc

$$P_c = V_{CE} * I_{CO} = 5V * 2,52 mA = 12,64 mW$$

Ahora calculamos la potencia máxima con los parámetros utilizados:

$$G_{pmax} = \frac{|S_{21}|^2}{(1 - |S_{11}|^2) * (1 - |S_{22}|^2)}$$
$$= \frac{18,55^2}{(1 - 0,45^2) * (1 - 0,99^2)} = 1147,84$$

Expresado en decibeles:

$$G_{dB} = 30,5 dB$$

Con esto se puede calcular la potencia de entrada:

$$P_{in} = \frac{P_c}{G_{nmax}} = \frac{12,64 \text{ mW}}{1147,84} = 11,01 \text{ }\mu W$$

Con la potencia de entrada se puede calcular Vin:

$$P_{in} = \left(\frac{\widehat{V_{IN}}}{\sqrt{2}}\right)^{2} * \frac{1}{R_{e}(Zin)} \to \widehat{V_{IN}} = \sqrt{2 * P_{in} * R_{e}(Zin)}$$
$$= \sqrt{2 * 11,01 \ \mu W * 58,57}$$
$$= 35,92 mV$$

3.2 Polarización de etapa de entrada:

Análisis en CA

Es un amplificador clase A, con un rendimiento del 50%

$$V_L = V_{RC} = 0.7v$$

$$I_L = \frac{V_L}{R_e(Zo)} = \frac{0.7}{122,61} = 5.7 \text{ mA}$$

$$I_{RC} = I_{CMAX} - I_L = 10m - 5.7m = 4.29mA$$

$$R_C = \frac{V_{RC}}{I_{RC}} = \frac{0.7v}{4.29mA} = 163.17\Omega$$

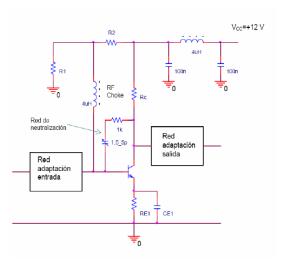


FIG. 2: ETAPA DE ENTRADA

Análisis en CC

$$V_{Re1} = V_{CC} - V_{CEQ} - I_{CQ} * R_C$$

= $12v - 5v - (10mA * 163,17)$
= $5.36V$

$$\begin{split} R_{e1} &= \frac{V_{Re1}}{I_{CQ}} = \frac{5,36 \text{V}}{10 \text{mA}} = 536,29 \Omega \\ I_{CMAX} &= \frac{V_{CC}}{R_{e1} + R_{C}} = \frac{12 V}{536,29 \Omega + 163,17 \Omega} = 17,15 \ mA \end{split}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} * (R_{e1} + R_C)$$

= 12v - 10mA
* (536,29\Omega + 163,17\Omega) = 5v

$$\Delta V_{CEQ} = I_{CQ} \frac{R_C * R_L}{R_C + R_L} = 10 mA \frac{(163,16\Omega)^2}{2 * (163,16\Omega)} = 0.82 V$$

Si se conoce que hfe=50

$$R_B = \frac{hfe * R_{e1}}{10} = \frac{50 * 536,29}{10} = 2681,45\Omega$$

$$V_{BB} = \frac{I_{CQ}}{\text{hfe}} * R_B + V_{BE} + I_{CQ} * R_{e1}$$
$$= \frac{10\text{mA}}{50} * 2681,45\Omega + 0,7v$$
$$+ 10\text{mA} * 536,29\Omega = 6.6V$$

$$R_1 = \frac{R_B * V_{cc}}{V_{BB}} = \frac{2681,45\Omega * 12\nu}{6,6\text{v}} = 4875,36\Omega$$

$$R_2 = \frac{R_B}{1 - \frac{V_{BB}}{V_{CC}}} = \frac{2681,45\Omega}{1 - \frac{6,6V}{12V}} = 5658,77\Omega$$

$$C_{e1} \ge \frac{1}{2 * \pi * F_{MAX} * \frac{R_{e1}}{10}} = \frac{1}{2 * \pi * 88MHz * \frac{536,29\Omega}{10}} = 33pF$$

4. Diseño de la etapa intermedia.

En la hoja de datos del componente BFR96 se obtuvo:

- $P_{Out\ M\acute{a}x} = 700 \text{mW}$ $V_{CC} = 5v$ $I_{C\ M\acute{a}x} = 100 \text{mA}$ $F_{M\acute{a}x} = 175 \text{MHz}$

- Gain > 11.5 dB@500MHz

Para entregar al BFR96 la potencia necesaria sumamos 1.12mW a la potencia de entrada calculada anteriormente, por

$$P_{out} = 83,91mW + 1,12 mW = 93,9792 mW$$

4.1 Impedancia:

A partir de la hoja de datos, se obtienen los parámetros S:

- $S_{11} = 0.37 L^{-150} = -0.32 j0.185$ $S_{22} = 0.399 L^{-55.7} = 0.225 j0.330$ $S_{12} = 0.022 L^{69.6}$ $S_{21} = 10.78 L^{96}$

Con estos datos, es posible calcular la impedancia de entrada

$$Z_{IN} = \frac{1 + S_{11}}{1 - S_{11}} * R_L = \frac{1 + (-0.32 - j0.185)}{1 - (-0.32 - j0.185)} * 50$$
$$= 24,298 - j10,41$$

$$Z_{OUT} = \frac{1 + S_{22}}{1 - S_{22}} * R_L = \frac{1 + (0,225 - j0,330)}{1 - (0,225 - j0,330)} * 50$$
$$= 59,22 - j46,51$$

Se calcula la tensión de salida:

$$\widehat{V_o} = \sqrt{2 * P_{out} * R_e(Zo)} = \sqrt{2 * 93,97 \text{mW} * 59,22}$$

= 3.33V

Con la cual se puede calcular la corriente para MES:

$$I_{CQ} = \frac{\hat{V_o}}{R_e(Zo)} = \frac{3,33V}{59,32} = 56,2 \text{ mA}$$

Con ambos valores, se puede obtener la potencia Pc

$$P_c = V_{CE} * I_{CO} = 5V * 56,2mA = 281,19 mW$$

Ahora calculamos la potencia máxima con los parámetros utilizados:

$$G_{pmax} = \frac{|S_{21}|^2}{(1 - |S_{11}|^2) * (1 - |S_{22}|^2)} = 789,75w$$

Expresado en decibeles:

$$G_{dB} = 28,97 \ dB$$

Con esto se puede calcular la potencia de entrada:

$$P_{in} = \frac{P_c}{G_{pmax}} = \frac{278 \text{ mW}}{789,7\text{W}} = 0,352 \text{ mW}$$

Se calcula la tensión de salida:

$$P_{in} = \left(\frac{\widehat{V_{IN}}}{\sqrt{2}}\right)^{2} * \frac{1}{R_{e}(Zin)} \to \widehat{V_{IN}} = \sqrt{2 * P_{in} * R_{e}(Zin)}$$
$$= \sqrt{2 * 0.352W * 24.29}$$
$$= 130.74mV$$

4.2 Polarización de etapa intermedia:

• Análisis en CC

$$V_{Re2} = V_{CC} - V_{CEQ} = 12v - 5v = 7V$$

$$R_{e2} = \frac{V_{Re2}}{I_{CQ}} = \frac{7V}{56,2\text{mA}} = 124,55\Omega$$

$$I_{CMAX} = \frac{V_{CC}}{R_{e1} + R_C} = \frac{12V}{536,29\Omega + 163,17\Omega} = 17,15 \text{ mA}$$

Si se conoce que hfe=75

$$R_B = \frac{hfe * R_{e2}}{10} = \frac{75 * 124,55}{10} = 934,16\Omega$$

$$V_{BB} = \frac{I_{CQ}}{\text{hfe}} * R_B + V_{BE} + I_{CQ} * R_{e2}$$
$$= \frac{56,2\text{mA}}{75} * 934,16\Omega + 0,7\text{v}$$
$$+ 56,2\text{mA} * 124,5\Omega = 8,39\text{V}$$

$$R_3 = \frac{R_B * V_{cc}}{V_{BB}} = \frac{934,16\Omega * 12\nu}{8,39V} = 1,33K\Omega$$

$$\begin{split} R_4 &= \frac{R_B}{1 - \frac{V_{BB}}{V_{CC}}} = \frac{934,16\Omega}{1 - \frac{8,39V}{12V}} = 3,1K\Omega \\ C_{e1} &\geq \frac{1}{2 * \pi * F_{MAX} * \frac{R_{e1}}{10}} = \frac{1}{2 * \pi * 88MHz * \frac{124,55\Omega}{10}} \\ &= 145,2pF \end{split}$$

5. Adaptación d impedancias

En el apartado anterior, se mencionó la adaptación de las impedancias calculadas. Esta se realizó en forma gráfica con el ábaco de Smith:

Se adaptan los 50Ω del modulador de FM con la impedancia de entrada del transistor BFR90 (Zin=58.575-j53.7)

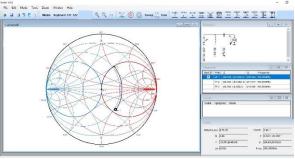


FIG. 3. ADAPTACIÓN DE Z_{IN} DEL BFR90 CON 50Ω

Se adapta luego, la Impedancia de salida del BFR90(Zout=122.61-j184.75) con la impedancia de entrada del BFR96(Zin=24.298-j10.41).

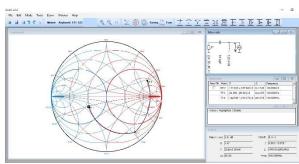


Fig. 4. Adaptación de \boldsymbol{Z}_{OUT} del BFR90 con \boldsymbol{Z}_{IN} del BFR96

Se adapta la impedancia de salida del BFR96(Zout=59.22-j46.51) con la impedancia de entrada del 2N4427(Zin=8.6-j7.32).

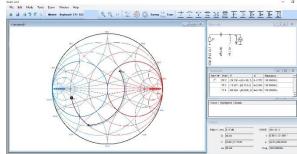


FIG. 5. ADAPTACIÓN DE Z_{OUT} DEL BFR96 CON Z_{IN} DEL 2N4427

Por último se adapta la impedancia de salida del 2N4427(Zout=53.20-j28.91) con una carga de 50 Ω

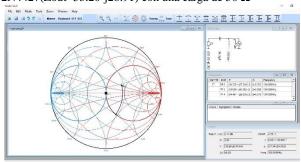
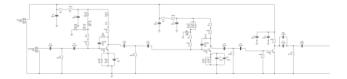


Fig. 6. Adaptación de $Z_{\it out}$ del 2n3866 con 50Ω

6. Esquemático

En la siguiente figura se presenta el circuito final del amplificador RF.



V. CONCLUSIÓN.

Este trabajo practico nos sirvió como primera experiencia con un circuito en altas frecuencias; podemos mencionar los cuidados o precauciones que debimos tomar para su correcto funcionamiento, como por ejemplo utilizar bobinas de choques en serie con bobinas de 1uF, los largos de las patas de los componentes debían ser lo más corta posibles, y en el mejor de los casos utilizar SMD a fin de eliminar el estado oscilatorio, entre otros.

Para obtener una ganancia aceptable, se debió adaptar impedancias para los 3 transistores utilizados, de esta forma se minimizo las ondas reflejadas y acercar el ROE lo más posible a la unidad.